

УДК 537.312.62

© 1991

## КРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИТИЕВОГО ИНТЕРКАЛЯТА $2H\text{-NbSe}_2$

*B. A. Кульбачинский*

Исследованы анизотропия критических магнитных полей и температура сверхпроводящего перехода диселенида ниобия  $2H$  модификации, интеркалированного литием до образования первой ступени. Обнаружены увеличение анизотропии сверхпроводящих свойств, понижение температуры сверхпроводящего перехода и подавление волны зарядовой плотности в интеркалированных образцах.

Слоистые дихалькогениды переходных металлов типа  $\text{MX}_2$ , где  $\text{M}$  — переходной металл, а  $\text{X}=\text{S}, \text{Se}, \text{Te}$  легко интеркалируются атомами металлов или органическими молекулами [1]. Это обстоятельство обусловлено тем, что структура слоистых кристаллов состоит из трехслойных пакетов, внутри которых слои расположены в последовательности  $\text{X}-\text{M}-\text{X}$  с преимущественно ковалентной связью между ними, а между пакетами осуществляется ван-дер-ваальсовы щели и заходят молекулы интеркалята. Наличие слабой ван-дер-ваальсовой связи между пакетами приводит к тому, что соседние пакеты могут упаковываться различным образом по отношению друг к другу, следствием чего является наличие большого числа политипов. Наиболее распространенными являются  $2H$  и  $1T$ , цифра означает количество пакетов в элементарной ячейке, а буква — структуру:  $H$  — гексагональная,  $T$  — октаэдрическая.

У многих дихалькогенидов переходных металлов наблюдается при понижении температуры переход с образованием волны зарядовой плотности (ВЗП). Исследование ВЗП посвящено большое число работ [2, 3], Фазовый переход в ВЗП обнаруживается различными методами, в том числе по зависимости сопротивления от температуры [4], на которой появляется особенность. В сверхпроводящих дихалькогенидах переходных металлов обнаруживается корреляция между температурой перехода  $T_0$  в ВЗП и температурой  $T_c$  перехода в сверхпроводящее состояние: чем выше температура  $T_0$ , тем ниже  $T_c$ , т. е. ВЗП подавляет сверхпроводящий переход. Исследования под давлением [5, 6] подтверждают этот вывод: под действием всестороннего сжатия  $T_c$  растет, а  $T_0$  падает.

В настоящей работе исследовались монокристаллы  $2H\text{-NbSe}_2$ , как чистые, так и интеркалированные литием, с характерными размерами  $4\times 4$  мм. В исходных монокристаллах параметры решетки составляли  $a=3.45$  Å,  $c=2\cdot 6.28$  Å. Состав интеркалированных образцов соответствовал формуле  $\text{Li}_{0.85}\text{NbSe}_2$  с параметрами решетки  $a=3.50$  Å,  $c=2\times 6.78$  Å. Параметры решетки соответствуют интеркалированному соединению первой ступени [7, 8], т. е. заполнению молекулами интеркалята каждой ван-дер-ваальсовой щели. В интеркалированных дихалькогенидах переходных металлов обнаружены четко выраженное образование не только первой ступени, но и (второй интеркалят заполняет ван-дер-ваальсовые щели через одну), третьей [7, 9].

Измерения температурных зависимостей сопротивления проводились по стандартной четырехконтактной методике на постоянном токе при величине плотности тока не более  $2 \text{ A/cm}^2$ . Ток направлялся вдоль слоев. Измерения в магнитном поле проводились при переменной ориентации вектора магнитной индукции  $\mathbf{B}$  от направления, перпендикулярного слоям (угол  $\theta=90^\circ$ , определялось  $H_{c2\perp}$ ), до направления, параллельного слоям (угол  $\theta=0^\circ$ , определялось  $H_{c2\parallel}$ ); при этом ток оставался перпендикулярным направлению магнитного поля.

На рис. 1 приведены зависимости от температуры сопротивлений исходного и интеркалированного образцов. В исходных образцах при  $T_0 \sim 33 \text{ K}$  наблюдается особенность, связанная с возникновением ВЗП (отмечена стрелкой). В интеркалированных образцах такая особенность отсутствует. Температура сверхпроводящего перехода уменьшается в интеркалированных образцах до  $5.2 \text{ K}$  от  $7.2 \text{ K}$  у исходных.

Зависимости критического магнитного поля  $H_{c2}$  от угла при  $T=4.2 \text{ K}$  у интеркалированного образца и способ его определения показаны на рис. 2. На рис. 3 приведены зависимости  $H_{c2\perp}$  и  $H_{c2\parallel}$  от температуры.

Таким образом, интеркалирование литием  $2H\text{-NbSe}_2$  подавляет ВЗП, как и вообще донорное интеркалирование [1, 3] в отличие от акцепторного [10]. Однако в обоих случаях  $T_c$  уменьшается. В  $2H\text{-NbSe}_2$  при возникновении ВЗП число носителей тока изменяется незначительно, хотя изменяется их подвижность. Основной причиной изменения  $T_c$  в  $2H\text{-NbSe}_2$  в отличие от других сверхпроводящих дихалькогенидов переходных металлов, по-видимому, является изменение плотности состояний на уровне Ферми при интеркалировании в модели жестких зон [11, 12].

Для объяснения угловой зависимости верхнего критического поля  $H_{c2}(\theta)$  была предложена простая модель, основанная на приближении эффективных масс [13], которая хорошо описывает анизотропию критических полей в  $2H\text{-NbSe}_2$ . В этой модели зависимости  $H_{c2}(\theta)$  описываются формулой

$$H_{c2}(\theta) = \frac{\Phi_0}{2\pi\xi_{\parallel}^2 (\sin^2 \theta + \epsilon^2 \cos^2 \theta)^{1/2}} = \frac{H_{c2\perp}}{(\sin^2 \theta + \epsilon^2 \cos^2 \theta)^{1/2}}, \quad (1)$$

где  $\Phi_0$  — квант магнитного потока,  $\xi_{\parallel}$  — длина когерентности в слое,  $\epsilon^2 = m_{\perp}/m_{\parallel} = \xi_{\perp}/\xi_{\parallel} = H_{c2\perp}/H_{c2\parallel}$ . Модель дает возможность определять отношение эффективных масс и, таким образом, степень анизотропии при движении носителей тока перпендикулярно и параллельно слоям. Модель хорошо описывает экспериментальные зависимости  $H_{c2}(\theta)$  в  $2H\text{-NbSe}_2$  [14], для которого  $\epsilon^2 \approx 0.14$  ( $\eta = H_{c2\parallel}/H_{c2\perp} \approx 2.7$  при  $4.2 \text{ K}$ ). В исследованных образцах после интеркалирования параметр  $\eta$  возрастает до  $\approx 6.2$ . Используя формулы (1), можно подсчитать, что параметр анизотропии  $\epsilon^2$  стал равным приблизительно 0.026. Угловые зависимости  $H_{c2}$  удовлетворительно описываются формулами (1) (штриховая линия на рис. 2). Особенностью зависимостей  $H_{c2}(T)$  в  $\text{Li}_{0.85}\text{NbSe}_2$  является наличие положительной кривизны как для  $H_{c2\parallel}$ , так и для  $H_{c2\perp}$  (рис. 3). Использовав модель [15, 16] джозефсоновского взаимодействия слоев, можно оценить параметр межслоевого взаимодействия по формуле

$$\delta = \frac{8\Phi_0}{(H_{c2\parallel}/H_{c2\perp}) \pi^2 d^2 T_c (dH_{c2\parallel}/dT)}, \quad (2)$$

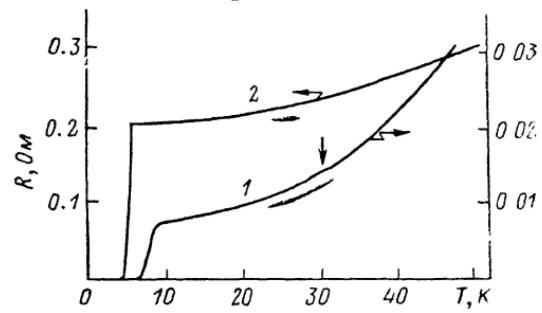


Рис. 1. Зависимости сопротивления от температуры исходного образца  $2H\text{-NbSe}_2$  (1);  $\text{Li}_{0.85}\text{NbSe}_2$  (2).

где  $d$  — расстояние между слоями после интеркалирования оно увеличивается на  $\approx 1 \text{ \AA}$ ). Согласно модели [15, 16], джозефсоновское взаимодействие слоев приведет к положительной кривизне  $H_{c2}(T)$  при  $\delta=1$ , однако для исходных образцов  $\delta > 100$ , а для интеркалированных, несмотря на возросшую анизотропию, величина  $\delta$  остается больше 10. Интересная

возможность объяснения этого эффекта предложена в [17], где положительная кривизна трактуется как результат различия в орбитальном эффекте при параллельной и перпендикулярной ориентации магнитного поля.

Используя соотношения теории Гинзбурга—Ландау, из зависимостей  $H_{c2\parallel}(T)$  и  $H_{c2\perp}(T)$  определили зависимости  $\xi_\parallel(T)$  и  $\xi_\perp(T)$ . Оказалось, что около  $T_c$  они хорошо описываются формулой

$$\xi(T) \sim \xi(0) \{T_c/(T_c - T)\}^{1/2}. \quad (3)$$

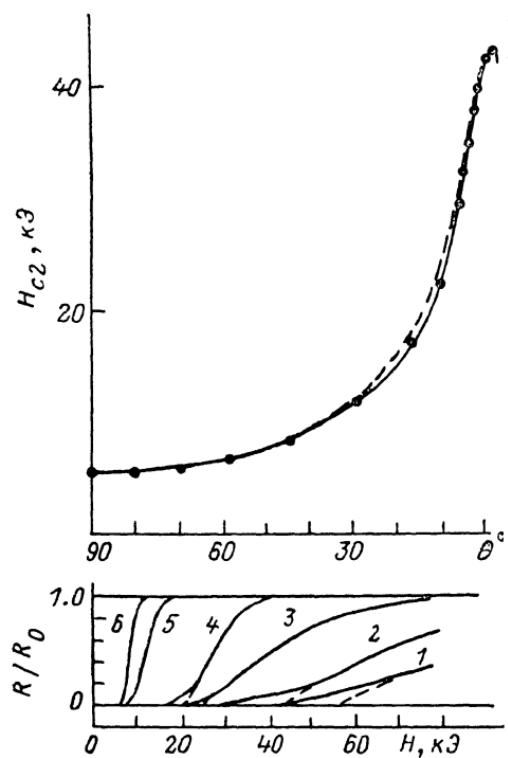


Рис. 2. Угловые зависимости второго критического поля для  $\text{Li}_{0.85}\text{NbSe}_2$ .

Штриховая кривая — расчет по формуле (1). Внизу — зависимости относительного изменения сопротивления от магнитного поля при различных направлениях магнитного поля относительно слоев. 1 — 0, 2 — 5, 3 — 10, 4 — 20, 5 — 55, 6 — 90°.  $R_0$  — сопротивление образца при  $H=0$ .

В связи с резким возрастанием  $H_{c2\parallel}(T)$  при понижении температуры не представилось возможным провести измерения в широком температурном интервале. Однако если предположить, что  $\eta=\text{const}$ , то из значений  $H_{c2\perp}(T)$  можно оценить  $\xi_\perp(T)$  до  $T=1.5 \text{ K}$ . При таких предположениях  $\xi_\perp(T)$  при  $T < 2 \text{ K}$  отклоняется от зависимости (3). При этих температурах величина  $\xi_\perp$  становится сравнимой с межслоевым расстоянием и должен произойти переход от анизотропной трехмерной сверхпроводимости к сверхпроводнику с джозефсоновским взаимодействием слоев. Однако для экспериментального наблюдения явления кроссовера в дихалькогениде ниobia, интеркалированного литием, необходимы существенно большие магнитные поля.

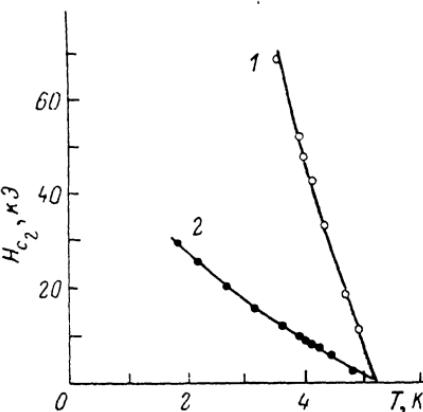


Рис. 3. Зависимости второго критического поля от температуры при направлениях вдоль (1) и перпендикулярно (2) слоям.

#### Список литературы

- [1] Physics and Chemistry of material with Layered Structures / Ed. by F. Levy. 1979. V. 6.
- [2] Булаевский Л. Н. // УФН. 1975. Т. 116. № 3. С. 449—483.
- [3] Wilson J. A., Di Salvo F. J., Makajian S. // Adv. Phys. 1975. V. 24. N 2. P. 117—201.
- [4] Takita K., Masuda K. // J. Low Temp. Phys. 1985. V. 58. N 1/2. P. 127—142.
- [5] Molinie P., Jerome D., Grant A. // Phil. Mag. 1974. V. 30. N 5. P. 1091—1103.
- [6] Jerome D., Benthier C., Molinie P., Rouxel J. // J. Phys. C. 1977. V. 4. P. 125—135.
- [7] Dahn D. C., Haering R. R. // Sol. St. Comm. 1982. V. 44. N 1. P. 29—32.
- [8] McCewen C. S., Julien D. J., Edwards P. P., Sienko M. J. // Inorganic Chemistry. 1985. V. 24. N 11. P. 1656—1660.

- [9] Rajora O. S., Curson A. E. // Phys. Stat. Sol. (a). 1986. V. 97. N 1. P. 65—76.
- [10] Оболенский М. А., Чашка Х. Б., Беленький В. И., Балла Д. Д., Стародуб В. А. // ФНТ. 1982. Т. 8. № 2. С. 174—179.
- [12] Mattheiss L. F. // Phys. Rev. B. 1973. V. 8. N 8. P. 3719—3740.
- [13] Frindt R. F., Huntley D. J. // Phys. and Chemistry of materials with layered structures / Ed. by P. A. Lee. 1976. V. 4. P. 403—422.
- [14] de Trey P., Gygax S., Jan J.-P. // J. Low Temp. Phys. 1973. V. 11. N 3/4. P. 421—434.
- [15] Klemm R. A., Luter A., Beastly M. R. // Phys. Rev. 1975. V. 12. N 3. P. 877—890.
- [16] Булаевский Л. Н., Гусейнов А. А. // ЖЭТФ. 1974. Т. 19. № 12. С. 742—744.
- [17] Оболенский М. А., Сик Зо Ен, Белецкий В. В., Чашка Х. Б., Гвоздиков В. М. // ФНТ. 1985. Т. 11. № 12. С. 1239—1244.

Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова

Поступило в Редакцию  
27 июня 1990 г.